

УДК 537.226.633

МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В BiFeO_3

Р.М. ИСМАИЛОВ

Сектор Радиационных Исследований АН Азербайджана
370143, Баку, пр. Г.Джавида 31а

Проведены магнитоэлектрические исследования в сегнетомагнитных кристаллах BiFeO_3 . Изучены зависимости индуцированной магнитным полем электрической поляризации ($P_{\text{ин}}$) от напряженности магнитного поля (H) при различных температурах и $P_{\text{ин}}(H)$ для неполяризованного и поляризованного кристалла BiFeO_3 при комнатной температуре. Показано, что по магнитоэлектрическим данным при комнатной температуре выше BiFeO_3 является антисегнетоэлектриком.

Современная техника непрерывно требует создания новых материалов, обладающих комплексом практически важных свойств. В этой связи в настоящее время интенсивно исследуются кристаллы, обладающие одновременно несколькими подсистемами.

Среди них особо следует отметить сравнительно недавно открытый новый класс веществ – сегнетомагнетики, в кристаллических решетках которых одновременно существуют магнитное и электрическое упорядочения. Открытие сегнетомагнитных кристаллов положило начало новому направлению в физике твердого тела – комплексному исследованию взаимосвязи электрических и магнитных свойств в этих кристаллах. Одним из чувствительных физических методов изучения этой взаимосвязи является магнитоэлектрический эффект (МЭЭ).

В этой работе проведены МЭ-ие исследования в феррите висмута – BiFeO_3 . Следует отметить, что первая попытка изучения взаимосвязи между электрической и магнитной подсистемами в BiFeO_3 с помощью МЭЭ была сделана в [1]. Однако в этой работе не было проведено тщательного исследования. Такие вопросы, как зависимость индуцированной магнитным полем электрической поляризации от температуры $P_{\text{ин}}(T)$, зависимость величины критического магнитного поля H_c от температуры, влияние поляризации образцов на их магнитоэлектрические характеристики, в частности на H_c и $P_{\text{ин}}$ и др. не были изучены. Решение именно этих задач может ответить на вопрос относительно типа упорядочения электрической подсистемы BiFeO_3 . В этой связи нами были проведены более детальные исследования МЭЭ в поликристаллическом образце BiFeO_3 .

Проведенные нами измерения зависимостей индуцированной магнитным полем электрической поляризации $P_{\text{ин}}$ от напряженности магнитного поля $P_{\text{ин}}(H)$ в интервале температур 300–450 К и в магнитных полях до 15 кЭ для BiFeO_3 показали, что в полях примерно до $H=1 \div 2$ кЭ эта зависимость носит линейный характер (Рис.1). С возрастанием напряженности магнитного поля зависимость $P_{\text{ин}}(H)$ становится нелинейной и в поле $H=5$ кЭ величина индуцированной поляризации $P_{\text{ин}}$ достигает максимального значения. При дальнейшем увеличении напряженности магнитного поля происходит резкое уменьшение величины $P_{\text{ин}}$. Такое изменение величины $P_{\text{ин}}$ при $H=H_c$ объясняется изменением спин-конфигурации кристалла – изменением магнитной симметрии, обусловленной поворотом вектора намагниченности магнитной подрешетки под действием внешнего магнитного поля (опрокидыванием спинов). Для BiFeO_3 в поле спинфлопа ($H_c=5$ кЭ) результаты показывают, что МЭЭ обусловлен обменным взаимодействием электрической и магнитной подсистем.

Величина поля опрокидывания $H_c=5$ кЭ и обменный характер взаимодействий электрической и магнитной подсистем, полученные для BiFeO_3 из экспериментальных

исследований МЭЭ, удовлетворительно согласуются с теоретическими данными, полученными Чупис [2,3].

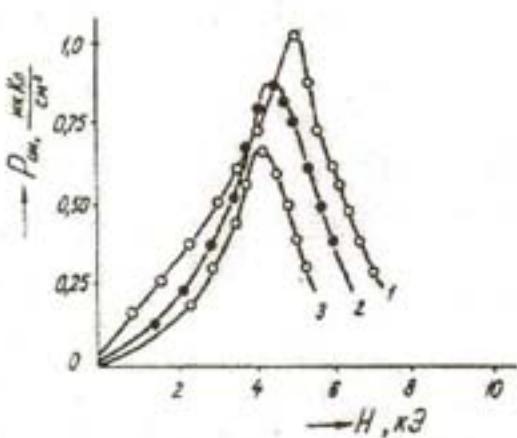


Рис.1

Зависимость индуцированной магнитным полем электрической поляризации ($P_{\text{ин}}$) от напряженности приложенного магнитного поля (H) для BiFeO_3 при температурах (1) 293, (2) 338 и (3) 358 К.

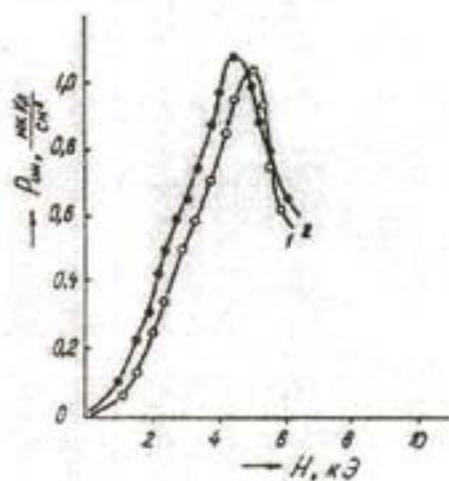


Рис.2

Зависимость индуцированной магнитным полем электрической поляризации ($P_{\text{ин}}$) от напряженности магнитного поля (H) для поляризованных (2) и неполяризованных (1) образцов BiFeO_3 при комнатной температуре.

При изучение МЭЭ в феррите висмута также было обнаружено влияние предварительной электрической поляризации на магнитоэлектрические характеристики образцов, в частности, на индуцированную магнитным полем электрическую поляризацию ($P_{\text{ин}}$) и на спин-опрокидывающего магнитного поля (H_c). Установлено, что в поляризованном электрическом поле $E=15 \div 20 \text{ кВ/см}$ (в течение 2 час.) в феррите висмута величина индуцированной поляризации несколько увеличивается, тогда как напряженность критического магнитного поля уменьшается. Эта зависимость графически представлена на Рис.2. Видно, что как неполяризованный (1), так и поляризованный (2) кристалл BiFeO_3 при $H=0$ не обладает электрической поляризацией ($P=0$), что согласуется с наличием антисегнетоэлектрического состояния в этом кристалле.

Таким образом, согласно магнитоэлектрическим данным, феррит висмут является антисегнетоэлектриком при комнатной температуре и выше, обладающим полярной пространственной группой.

1. I.H.Ismailzade, R.G.Jagupov, *Phys Stat Sol.(a)*, **32** (1975) к161.
2. И.Е. Чупис, *Украинский физический журнал*, **23** №36 (1978) 396.
3. И.Е. Чупис *ФНТ*, **2** №6 (1976) 762.

BiFeO₃ KRİSTALINDA MAQNETOELEKTRİK EFFEKTİ

R.M.İSMAYILOV

BiFeO₃ kristalində maqnetoelektrik tədqiqatlar aparılmışdır. Xarıji maqnit sahəsinin tə'siri ilə yaranmış elektrik poliarizasiyası P_{in} - nin müxtəlif temperaturlarda xarıji maqnit sahəsinin gərginliyindən asılılığına baxılmışdır. Digər tərəfdən otaq temperaturunda P_{in} asılılığına xarıji elektrik sahəsində poliarizo olunmuş və poliarize olunmamış BiFeO₃ kristalində baxılmışdır.

Maqnetoelektrik nəticələr əsasında müəyyən edilmişdir ki, BiFeO₃ otaq və yuxarı temperaturlarda antiseqnetoelektrikdir.

MAGNETOELECTRIC EFFECT in CRYSTAL BiFeO₃

R.M.ISMAILOV

The magnetoelectric investigations segnetomagnetic crystals BiFeO₃ were carried out. The electric polarization dependence P_{in} induced by magnetic field (H) at various temperatures was studied. $P_{in}(H)$ at room temperature for polarized in external electric field and non polarized BiFeO₃ crystals were studied too. BiFeO₃ was shown to be antisegnetoelectric according to the magnetoelectric data at room temperature and over.

Редактор: Г.Аждаров